

BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-158216

(43)Date of publication of application : 31.05.2002

(51)Int.CI.

H01L 21/3065
B01J 19/08
C23C 16/52
H01L 21/205
H05H 1/46

(21)Application number : 2001-010781

(71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD
YASAKA YASUNORI

(22)Date of filing : 18.01.2001

(72)Inventor : ISHII NOBUO
YASAKA YASUNORI

(30)Priority

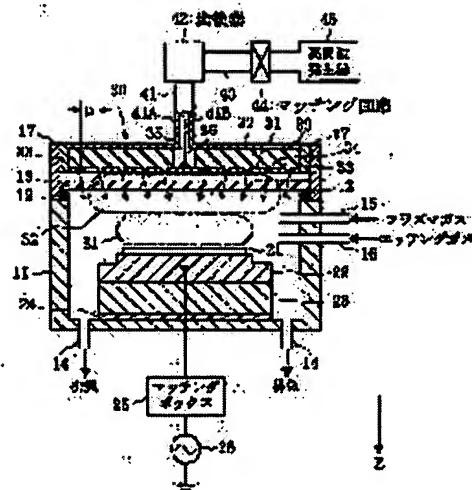
Priority number : 2000270545 Priority date : 06.09.2000 Priority country : JP

(54) PLASMA PROCESSOR AND METHOD THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the distribution of a plasma generated by a high frequency electromagnetic field.

SOLUTION: The plasma processor uses a slot antenna 30 for radiating an electromagnetic field in a process chamber 11 from a plurality of slots 34 on a radiation surface 31. The slot antenna 30 radiates the electromagnetic field in a direction inclined to the normal Z on its radiation surface 31.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 24.08.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 03.02.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 2004-04409

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 04.03.2004

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-158216

(P2002-158216A)

(43)公開日 平成14年5月31日 (2002.5.31)

(51)Int.Cl.⁷
H 01 L 21/3065
B 01 J 19/08
C 23 C 16/52
H 01 L 21/205
H 05 H 1/46

識別記号

F I
B 01 J 19/08
C 23 C 16/52
H 01 L 21/205
H 05 H 1/46
H 01 L 21/302

テマコード(参考)
H 4 G 0 7 5
4 K 0 3 0
5 F 0 0 4
L 5 F 0 4 5
B

審査請求 有 請求項の数17 OL (全 18 頁)

(21)出願番号 特願2001-10781(P2001-10781)
(22)出願日 平成13年1月18日 (2001.1.18)
(31)優先権主張番号 特願2000-270545(P2000-270545)
(32)優先日 平成12年9月6日 (2000.9.6)
(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000219967
東京エレクトロン株式会社
東京都港区赤坂5丁目3番6号

(71)出願人 599019546
八坂 保能
京都府宇治市木幡須留5-107

(72)発明者 石井 信雄
東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター 東京エレクトロン株式会社内

(72)発明者 八坂 保能
京都府宇治市木幡須留5-107

(74)代理人 100064621
弁理士 山川 政樹

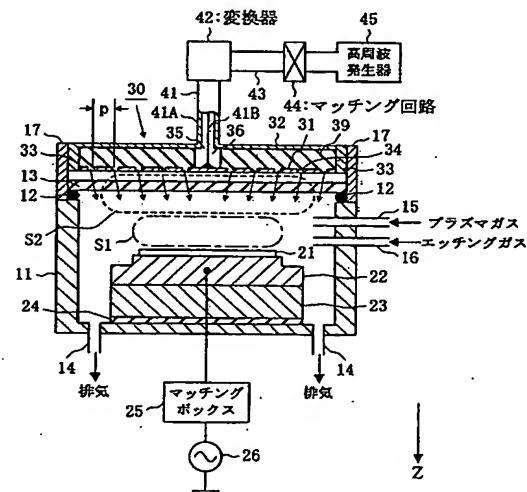
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 プラズマ処理装置及び方法

(57)【要約】

【課題】 高周波の電磁界により生成されたプラズマの分布を改善する。

【解決手段】 放射面31に形成された複数のスロット34より処理容器11内に電磁界を放射するスロットアンテナ30を用いたプラズマ処理装置であって、スロットアンテナ30が、その放射面31の法線方向Zに対して傾斜する方向に電磁界を放射する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 处理容器内に収容され被処理体を配置する載置面を有する載置台と、この載置台の載置面に対向配置され放射面に形成された複数のスロットより前記処理容器内に電磁界を放射するスロットアンテナとを備えたプラズマ処理装置において、

前記スロットアンテナは、前記放射面の法線方向に対して傾斜する方向に前記電磁界を放射することを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項2】 請求項1記載のプラズマ処理装置において、

前記スロットアンテナ内部の比誘電率 ϵ_v と前記スロットアンテナ外部の比誘電率 ϵ_a との比 ϵ_v/ϵ_a を ϵ_r 、前記スロットアンテナ内部を伝搬する電磁界の波長を λ_g 、前記スロットアンテナ内部での電磁界の伝搬方向における隣接スロット間のピッチを $p = \alpha \cdot \lambda_g$ ($\alpha > 0$)とし、Nを0以上の整数とすると、

$$-1 \leq \epsilon_r^{1/2} (N/\alpha - 1) \leq 1$$

かつ Nが1以上の場合に、 $N \neq \alpha$ を満たすように ϵ_r 、N、 α が設定されていることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項3】 請求項2記載のプラズマ処理装置において、

前記隣接スロット間のピッチは、前記スロットアンテナ内部での電磁界の伝搬方向で変化していることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項4】 請求項1～3何れか1項記載のプラズマ処理装置において、

前記スロットアンテナと前記載置台の載置面とを隔離するように配置され前記スロットアンテナの放射面に対して傾斜する面を有する誘電体部材を更に有することを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項5】 請求項4記載のプラズマ処理装置において、

前記誘電体部材は、ドーム状をしていることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項6】 請求項4記載のプラズマ処理装置において、

前記誘電体部材は、処理容器の内面の少なくとも一部を前記載置台の載置面から隔離することを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項7】 請求項1～3何れか1項記載のプラズマ処理装置において、

前記スロットアンテナと前記載置台の載置面とを隔離するように配置され前記スロットアンテナの放射面に対して傾斜する面を有する第1の誘電体部材と、この第1の誘電体部材に対して前記載置台と異なる側に配置され前記第1の誘電体部材と共に密閉空間を形成する第2の誘電体部材と、

前記密閉空間に流体を流通させて前記第1の誘電体部材

の温度調整をする流通手段とを更に有することを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項8】 請求項1～7何れか1項記載のプラズマ処理装置において、

前記スロットアンテナは、互いに離間して対向配置された第1及び第2の導体板と、外周部で前記第1の導体板と前記第2の導体板との間にシールドするリング部材とを備え、前記第1の導体板に前記複数のスロットが形成され、前記第1の導体板と前記第2の導体板との間に電磁界を導入する導入口が前記第2の導体板の中央部に形成されたラジアルアンテナであることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項9】 請求項1～7何れか1項記載のプラズマ処理装置において、

前記スロットアンテナは、矩形導波路の一面に前記複数のスロットが形成された矩形導波路アンテナであることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項10】 スロットアンテナの放射面より処理容器内に電磁界を放射し、この電磁界で生成されたプラズマにより被処理体に対して所定の処理を行うプラズマ処理方法において、

前記スロットアンテナが前記放射面の法線方向に対して傾斜する方向に前記電磁界を放射することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項11】 請求項9記載のプラズマ処理方法において、

前記スロットアンテナ内部の比誘電率 ϵ_v と前記スロットアンテナ外部の比誘電率 ϵ_a との比 ϵ_v/ϵ_a を ϵ_r 、前記スロットアンテナ内部を伝搬する電磁界の波長を λ_g 、前記スロットアンテナ内部での電磁界の伝搬方向における隣接スロット間のピッチを $p = \alpha \cdot \lambda_g$ ($\alpha > 0$)とし、Nを0以上の整数とすると、

$$-1 \leq \epsilon_r^{1/2} (N/\alpha - 1) \leq 1$$

かつ Nが1以上の場合に、 $N \neq \alpha$ を満たすように ϵ_r 、N、 α を設定することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項12】 請求項11記載のプラズマ処理方法において、

前記スロットアンテナ内部での電磁界の伝搬方向で前記隣接スロット間のピッチを変えて、この方向で電磁界の放射方向を変えることにより、プラズマの分布を調整することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項13】 請求項10記載のプラズマ処理方法において、

前記スロットアンテナと前記被処理体とを隔離する誘電体部材から前記スロットアンテナまでの距離を変えて、電磁界の放射方向を変えることにより、プラズマの分布を調整することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項14】 請求項10～12何れか1項記載のプラズマ処理方法において、

前記スロットアンテナの放射面に対して傾斜する面を有し前記スロットアンテナと前記被処理体とを隔離する誘電体部材を配置することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項15】 請求項14記載のプラズマ処理方法において、

前記誘電体部材をドーム状に形成することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項16】 請求項14記載のプラズマ処理方法において、

前記誘電体部材で処理容器の内面の少なくとも一部を前記被処理体から隔離することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項17】 請求項10～12何れか1項記載のプラズマ処理方法において、

前記スロットアンテナの放射面に対して傾斜する面を有する第1の誘電体部材で前記スロットアンテナと前記被処理体とを隔離し、

この第1の誘電体部材に対して前記被処理体と異なる側に第2の誘電体部材を配置して前記第1及び第2の誘電体部材により密閉空間を形成し、

前記密閉空間に流体を流通させて前記第1の誘電体部材の温度を調整することを特徴とするプラズマ処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、高周波の電磁界によりプラズマを生成して所定の処理を行うプラズマ処理装置及び方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 半導体装置やフラットパネルディスプレイの製造において、酸化膜の形成や半導体層の結晶成長、エッチング、またアッシングなどの処理を行うために、プラズマ処理装置が多用されている。これらのプラズマ処理装置の中に、アンテナから処理容器内へ高周波の電磁界を導入して高密度プラズマを発生させる高周波プラズマ処理装置がある。この高周波プラズマ処理装置は、プラズマガスの圧力が比較的低くても安定してプラズマを生成することができるので、用途が広いという特色がある。

【0003】 図20は、従来の高周波プラズマ処理装置を用いたエッチング装置の構成を示す図である。この図20では、一部構成について断面構造が示されている。円筒形状の処理容器111の上部開口に、誘電体板113が水平配置されている。これらの接合部にシール部材112を介在させることにより、処理容器111内部の気密性を確保している。処理容器111の底部には真空排気用の排気口114が設けられ、また処理容器111の側壁にはガス供給用のノズル116が設けられている。処理容器111内には、エッチング対象の基板121を置くための載置台122が収容されている。この載置台122は、

置台122はバイアス用の高周波電源126に接続されている。

【0004】 また、誘電体板113上部にはラジアルアンテナ130が配設されている。誘電体板113及びラジアルアンテナ130の周囲はシールド材117によって覆われている。ラジアルアンテナ130は、ラジアル導波路136を形成する互いに平行な2枚の導体板131, 132と、これらの導体板131, 132の外周部を接続するリング部材133とから構成される。放射面を構成する導体板131には、スロット134が多数形成されている。ラジアル導波路136内を伝搬する電磁界の波長（以下、管内波長という）が λ_g であるとき、径方向における隣接スロット間のピッチ p_2 は管内波長と同じ λ_g に設定される。また、導体板132の中央部には、ラジアル導波路136内に電磁界を導入する導入口135が形成されている。この導入口135には導波路141を介して高周波発生器145が接続されている。

【0005】 次に、このエッチング装置の動作を説明する。まず、処理容器111内を所定の真空中にした後、ノズル116から例えばCF₄とArとの混合ガスを流量制御して供給する。この状態で、高周波発生器145から導波路141を介して、高周波の電磁界をラジアルアンテナ130に供給する。ラジアルアンテナ130に供給された電磁界はラジアル導波路136の内部を伝搬しつつ、導体板131に形成された多数のスロット134から放射される。径方向における隣接スロット間のピッチ p_2 が λ_g に設定されているので、この電磁界は導体板131（放射面）に対してほぼ垂直方向に放射される。そして、誘電体板113を透過して、処理容器111内に導入される。

【0006】 処理容器111内に導入された電磁界の電界は、処理容器111内のガスを電離させて、処理対象の基板121の上部空間S1にプラズマを生成する。このとき、処理容器111内に導入された電磁界のすべてが直接プラズマ生成によって吸収されるわけではない。吸収されずに残った電磁界は、処理容器111内で反射を繰り返して、ラジアルアンテナ130とプラズマ生成空間S1との間の空間S2に定在波を形成する。この定在波の電界もプラズマ生成に関与することが分かっている。このようにして生成されたプラズマのイオンは、載置台122の負電位によって引き出されて、エッチング処理に利用される。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 図20に示した従来のエッチング装置では、空間S2に形成された定在波がプラズマ生成に与える影響が大きい。この定在波の電界分布を制御することは困難であるので、従来のエッチング装置ではプラズマを均一に生成することができなかつた。例えば、このエッチング装置で処理容器111内に

生成されたプラズマを観察したところ、後掲する図10(a)に示されるように、プラズマ発生領域160の中央付近に、プラズマが高密度に発生する部分161A, 161Bが確認された。このため、従来では、処理対象の基板121で、プラズマが高密度になっている下の領域ほど、エッチング処理が速く進行するという問題が発生していた。このような処理量に斑が生じるという問題は、図20に示したエッチング装置だけでなく、従来のプラズマ処理装置に共通する問題であった。

【0008】本発明は、以上のような問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、高周波の電磁界により生成されたプラズマの分布を改善することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】このような目的を達成するために、本発明のプラズマ処理装置は、放射面に形成された複数のスロットより処理容器内に電磁界を放射するスロットアンテナを用いたプラズマ処理装置であって、スロットアンテナが、その放射面の法線方向に対して傾斜する方向に電磁界を放射することを特徴とする。誘電体板がアンテナ放射面に平行に配置されている場合、電磁界は誘電体板の法線方向に対して傾斜する方向に放射される。また、処理容器内において誘電体板と対向するプラズマ面はこの誘電体板に沿った形状となるので、スロットアンテナから誘電体板を介して処理容器内のプラズマに直接入射する電磁界は、このプラズマ面の法線方向に対して傾斜する方向に入射することになる。プラズマと誘電体板との境界からプラズマ密度がカットオフ密度となる地点に至るまでの電磁界の電界変化を簡単に説明すると、プラズマ面に平行な方向成分の強度はほぼ一定値を維持するが、プラズマ面の法線方向成分の強度は単調に大きくなつて行く。したがつて、電磁界をプラズマ面の法線方向に対して傾斜する方向に入射させることにより、プラズマ面の法線方向に入射させた場合と比較して、両成分を合成した電界強度を大きくさせることができる。これにより、スロットアンテナから直接入射した電磁界の電界によるプラズマ生成効率を向上させることができる。これにより、スロットアンテナから処理容器内に直接入射した電磁界の電界によるプラズマ生成への寄与が大きくなるので、処理容器内に形成される定在波の電界によるプラズマ生成への寄与が相対的に低くなる。前者は後者よりも制御が容易であるので、プラズマの分布を従来よりも改善することができる。

【0010】上述したプラズマ処理装置では、スロットアンテナ内部の比誘電率 ϵ_r とスロットアンテナ外部の比誘電率 ϵ_a との比 ϵ_r/ϵ_a を ϵ_r 、スロットアンテナ内部を伝搬する電磁界の波長を λ_g 、スロットアンテナ内部での電磁界の伝搬方向における隣接スロット間のピッチを $p = \alpha \cdot \lambda_g$ ($\alpha > 0$) とし、Nを0以上の整数とすると、

$$-1 \leq \epsilon_r^{1/2} (N/\alpha - 1) \leq 1$$

かつ Nが1以上の場合に、 $N \neq \alpha$ を満たすように ϵ_r , N, α を設定するとよい。これにより、スロットアンテナの放射面の法線方向に対して傾斜する方向に電磁界が放射される。ここで、前記隣接スロット間のピッチは、スロットアンテナ内部での電磁界の伝搬方向で変化していてもよい。これにより、電磁界の放射方向に分布をもたせて、プラズマの分布を調整することができる。

【0011】また、スロットアンテナと載置台の載置面とを隔離するように配置され、スロットアンテナの放射面に対して傾斜する面を有する誘電体部材を更に有するようにしてもよい。ここで、誘電体部材は、ドーム状をしていてもよい。また、誘電体部材は、処理容器の内面の少なくとも一部を載置台の載置面から隔離するものであつてもよい。あるいは、スロットアンテナと載置台の載置面とを隔離するように配置されスロットアンテナの放射面に対して傾斜する面を有する第1の誘電体部材と、この第1の誘電体部材に対して載置台と異なる側に配置され第1の誘電体部材と共に密閉空間を形成する第2の誘電体部材と、この密閉空間に流体を流通させて第1の誘電体部材の温度を調整する流通手段とを更に有するようにしてもよい。ここで、第2の誘電体部材は、第1の誘電体部材とスロットアンテナとの間に配置されてもよいし、スロットアンテナの給電線途中に配置されてもよい。

【0012】また、スロットアンテナとして、互いに離間して対向配置された第1及び第2の導体板と、外周部で第1の導体板と第2の導体板との間をシールドするリング部材とを備え、第1の導体板に複数のスロットが形成され、第1の導体板と第2の導体板との間に電磁界を導入する導入口が第2の導体板の中央部に形成されたラジアルアンテナを使用してもよい。また、スロットアンテナとして、矩形導波路の一面に複数のスロットが形成された矩形導波路アンテナを使用してもよい。

【0013】また、本発明のプラズマ処理方法は、スロットアンテナが放射面の法線方向に対して傾斜する方向に電磁界を放射して処理容器内に電磁界を供給し、この電磁界で生成されたプラズマにより被処理体に対して所定の処理を行うことを特徴とする。これにより、プラズマの分布を従来よりも改善することができる。このプラズマ処理方法では、スロットアンテナ内部の比誘電率 ϵ_r とスロットアンテナ外部の比誘電率 ϵ_a との比 ϵ_r/ϵ_a を ϵ_r 、スロットアンテナ内部を伝搬する電磁界の波長を λ_g 、スロットアンテナ内部での電磁界の伝搬方向における隣接スロット間のピッチを $p = \alpha \cdot \lambda_g$ ($\alpha > 0$) とし、Nを0以上の整数とすると、

$$-1 \leq \epsilon_r^{1/2} (N/\alpha - 1) \leq 1$$

かつ Nが1以上の場合に、 $N \neq \alpha$ を満たすように ϵ_r , N, α を設定するとよい。これにより、スロットアンテナの放射面の法線方向に対して傾斜する方向に電磁

界を放射することができる。ここで、スロットアンテナ内部での電磁界の伝搬方向で隣接スロット間のピッチを変えて、この方向で電磁界の放射方向を変えることにより、プラズマの分布を調整するようにしてもよい。

【0014】また、スロットアンテナと被処理体とを隔離する誘電体部材からスロットアンテナまでの距離を変えて、電磁界の放射方向を変えることにより、プラズマの分布を調整するようにしてもよい。また、スロットアンテナの放射面に対して傾斜する面を有しスロットアンテナと被処理体とを隔離する誘電体部材を配置するようにしてもよい。ここで、この誘電体部材をドーム状に形成してもよい。また、誘電体部材で処理容器の内面の少なくとも一部を被処理体から隔離するようにしてもよい。あるいは、スロットアンテナの放射面に対して傾斜する面を有する第1の誘電体部材でスロットアンテナと被処理体とを隔離し、この第1の誘電体部材に対して被処理体と異なる側に第2の誘電体部材を配置して第1及び第2の誘電体部材により密閉空間を形成し、この密閉空間に流体を流通させて第1の誘電体部材の温度を調整するようにしてもよい。ここで、第2の誘電体部材を、第1の誘電体部材とスロットアンテナとの間に配置してもよいし、スロットアンテナの給電線途中に配置してもよい。

【0015】

【発明の実施の形態】次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。

(第1の実施の形態)まず、本発明をエッティング装置に適用した例を説明する。図1は、本発明の第1の実施の形態であるエッティング装置の構成を示す図である。この図1では、一部構成について断面構造が示されている。また、説明の都合上、垂直方向をZ軸方向と定義する。

【0016】図1に示したエッティング装置は、上部が開口している円筒形状の処理容器11を有している。この処理容器11は、アルミニウムなどの導体部材で形成されている。処理容器11の上部開口には、平板状に成形された誘電体板13が水平に配置されている。この誘電体板13には、厚さ20~30mm程度の石英ガラス又は(A12O3又はAlN等)セラミックなどが用いられる。処理容器11と誘電体板13との接合部はOリングなどのシール部材12を介在させており、これにより処理容器11内部の気密性を確保している。

【0017】処理容器11の底部には、真空ポンプ(図示せず)に連通する排気口14が設けられており、処理容器11内部を所望の真空中にすることができる。また、処理容器11の側壁には、処理容器11内にArなどのプラズマガスを導入するためのプラズマガス供給ノズル15と、CF4などのエッティングガスを導入するための処理ガス供給ノズル16とが上下に設けられている。これらのノズル15、16は石英パイプなどで構成されている。処理容器11内には、エッティング対象の基

板(被処理体)21を配置する載置面を有する載置台22が収容されている。この載置台22は、処理容器11の底部に絶縁板24を介して固定された支持台23上に固定されている。また、載置台22はマッチングボックス25を介して、バイアス用の高周波電源26に接続されている。この高周波電源26は、例えば2~13.5MHzの高周波を発生する。

【0018】また、誘電体板13上部には、スロットアンテナの1つであるラジアルアンテナ30が、放射面(後述する導体板31)を下にして配設されている。このラジアルアンテナ30は、誘電体板13を介して処理容器11内に高周波の電磁界を放射するものである。ラジアルアンテナ30は、誘電体板13により処理容器11から隔離されており、処理容器11内で生成されるプラズマから保護されている。また、誘電体板13及びラジアルアンテナ30の周囲は、円筒形状のシールド部材17によって覆われている。このシールド部材17は、例えばアルミニウムなどの金属で形成されている。ラジアルアンテナ30から放射された電磁界は、このシールド部材17により遮蔽されるので、エッティング装置の外部に漏れることはない。

【0019】ラジアルアンテナ30は、同軸線路41、矩形・同軸変換器42及び矩形導波管43を介して、高周波発生器45に接続されている。この高周波発生器45は、例えば2.45GHzの高周波を発生するものである。なお、高周波発生器45の出力周波数は1GHz~10GHzの範囲内であればよい。また、矩形導波管43の途中にインピーダンスのマッチングを行うマッチング回路44を設けることにより、電力の使用効率を向上させることができる。

【0020】次に、ラジアルアンテナ30の構成について、さらに説明する。図1に示すように、ラジアルアンテナ30は、放射面を構成する第1の導体板31と、この導体板31に対して上方位置に対向配置された第2の導体板32と、導体板31、32の外周部を接続して導体板31、32間をシールドするリング部材33とから構成されている。アンテナ上面をなす導体板32の中央部には、2枚の導体板31、32により構成されるラジアル導波路36内に高周波発生器45からの高周波の電磁界を導入する導入口35が形成されている。また、アンテナ下面をなす導体板31には、多数のスロット34が形成されている。この導体板31は誘電体板13に平行に配置されている。

【0021】ラジアル導波路36内を伝搬する電磁界の波長(以下、管内波長といふ)が λ_g であるとき、2枚の導体板31、32の間隔は $\lambda_g/2$ 未満に設定される。例えば周波数が2.45GHzの高周波を使用する場合、ラジアル導波路36内の比誘電率 ϵ_r が1であれば、導体板31、32の間隔は6cm未満となる。 $\lambda_g/2$ 未満とすることにより、導体板31、32間に定在波

が形成されることを防止することができる。ただし、2枚の導体板31、32間の放電を防止するため、導体板31、32間の間隔を $0.5 / (\epsilon_r)^{1/2} \text{ cm}$ 以上することが望ましい。

【0022】以上の導体板31、32及びリング部材33は、銅又はアルミニウムなどの導体により形成される。なお、導体板31、32の間すなわちラジアル導波路36内に、図1に示すようにセラミックなどの誘電体部材（比誘電率 $\epsilon_r > 1$ ）39を配置してもよい。上述したように、ラジアルアンテナ30には、高周波発生器45に接続された同軸線路41が接続されている。この同軸線路41の外部導体41Aは、導体板32の導入口35周縁に接続されている。また、同軸線路41の内部導体41Bの先端は円錐状に成形され、この円錐の底部が導体板31の中心に接続されている。

【0023】図2は、ラジアルアンテナ30の放射面をなす導体板31の一構成例を示す図である。ここで、図2(a)は、導体板31全体の平面図、図2(b)は、導体板31の径方向において隣り合う2つのスロット34の拡大図である。図2(a)に示すように導体板31には、略周方向に延びるスロット34が、導体板31の中心の周りに同心円状に多数形成されている。この同心*

$$p/\lambda_g + (p \cdot \cos \theta)/\lambda = N$$

ここで、 θ は放射角度（導体板31に平行な方向と電磁界51A、51Bの放射方向とのなす角度）、 λ は真空中における電磁界51A、51Bの波長、Nは自然数で※

$$p = \alpha \cdot \lambda_g \quad (\alpha > 0)$$

また、比誘電率が ϵ_r であるラジアル導波路36内を伝

$$\lambda_g = \lambda / \epsilon_r^{1/2} = \lambda / \epsilon_r^{1/2}$$

で表されるので、(2)式及び(3)式を(1)式に代

$$\cos \theta = \epsilon_r^{1/2} [(N/\alpha) - 1]$$

【0027】(4)式より、 ϵ_r 、N、 α は

$$-1 \leq \epsilon_r^{1/2} [(N/\alpha) - 1] \leq 1$$

の関係を満たす必要がある。このとき、角度 θ が

$$\theta = \cos^{-1} [\epsilon_r^{1/2} [(N/\alpha) - 1]]$$

となる方向で電磁界51A、51Bの位相がそろい、この方向に電磁界が放射されることになる。しかし、

(4)式において $N = \alpha$ のとき、 $\cos \theta = 0$ すなわち $\theta = (2M-1)\pi/2$ （Mは自然数）となり、垂直方向に電磁界51A、51Bが放射されることになる。したがって、径方向における隣接スロット間のピッチpを、

(5)式を満たすと共に $N \neq \alpha$ となるように設計するこ★

$$N/[1 + (1/\epsilon_r^{1/2})] \leq \alpha \leq N/[1 - (1/\epsilon_r^{1/2})]$$

となるので、 $\epsilon_r = 9$ のとき、Nと α との関係は

$$3/4 \times N \leq \alpha \leq 3/2 \times N$$

で表される。図4は、(8)式により規定されるNと α との関係を棒グラフで表した図である。ただし、上述したように $N = \alpha$ のとき垂直放射となるので、図4では $N = \alpha$ の点を白丸で示し、除外している。

【0029】図4では、 $\alpha < N$ （各棒グラフにおける白

*円の半径は等差数列的に増えている。この同心円の半径の増加分を、径方向（すなわち、ラジアル導波路36内における電磁界の伝搬方向）における隣接スロット間のピッチpと定義する。この径方向における隣接スロット間のピッチpは、導体板31の法線方向すなわち垂直方向に対して傾斜する方向に電磁界が放射されるように設定される。

【0024】以下に、ピッチpの設計方法を説明する。ただし、誘電体板13はラジアルアンテナ30の放射面10（導体板31）から十分離れて配置され、ラジアルアンテナ30外部の等価比誘電率 ϵ_a は1に近似できるものとする。この条件下では、ラジアルアンテナ30内部（すなわちラジアル導波路36）の比誘電率 ϵ_r の値は、 ϵ_r と ϵ_a との比 ϵ_r （= ϵ_r / ϵ_a ）と等しくなる。

【0025】図3は、径方向における隣接スロット間のピッチpの設計方法の説明図である。電磁界の放射方向とは、放射された電磁界が強め合う方向である。電磁界の強め合いは、図3を用いて言えば、A点から放射される電磁界51Aと、A点からB点を経由してC点に達する電磁界51Bとが同じ位相となったときに起こる。その条件は(1)式に示すようになる。

$$\dots (1)$$

※ある。

【0026】いま、ピッチpを(2)式のように定義する。

$$\dots (2)$$

搬する電磁界の波長 λ_g は、

$$\dots (3)$$

入して整理すると、(4)式が得られる。

$$\dots (4)$$

$$\dots (5)$$

$$\dots (6)$$

★とにより、垂直方向に対して傾斜する方向に電磁界を放射させることができる。

【0028】以下、具体例を示す。まず、ラジアル導波路36内にAl₂O₃（ $\epsilon_r = \epsilon_a \approx 9$ ）からなる誘電体部材39が配置されている場合を示す。(5)式を変形すると、

$$\dots (7)$$

$$\dots (8)$$

丸の左側）で放射角度 θ が鋭角になり、 $\alpha > N$ （各棒グラフにおける白丸の右側）で放射角度 θ が鈍角になる。したがって、各棒グラフが相互に重なる部分（網目を付した部分）では、鋭角及び鈍角の両方向に電磁界が放射されることになる。なお、各棒グラフの左端は放射角度

$\theta = 0^\circ$ 、右端は放射角度 $\theta = 180^\circ$ となり、放射された電磁界は導体板 3 1 に沿った伝搬となる。 α が大きくなると、(2) 式よりスロット間のピッチ p が大きくなり、それに応じて導体板 3 1 に形成できるスロット 3 4 の数が少なくなり、電磁界の放射効率が低くなる。このため実用上は、 $N = 1, 0, 75 \leq \alpha \leq 1, 5, \alpha \neq 1$ とするのが望ましい。図 5 は、この条件下における放射角度 θ のスロットピッチ p 依存性を示す図である。横*

$$-1 \leq (N/\alpha) - 1 \leq 1$$

すなわち、

$$\alpha \geq N/2$$

となる。図 6 は、(10) 式により規定される N と α の関係を棒グラフで表した図である。ただし、上述したように $N = \alpha$ のとき垂直放射となるので、図 6 では $N = \alpha$ の点を白丸で示し、除外している。

【0031】図 6 では、 $\alpha < N$ (各棒グラフにおける白丸の左側) で放射角度 θ が鋭角になり、 $\alpha > N$ (各棒グラフにおける白丸の右側) で放射角度 θ が鈍角になる。また、各棒グラフが相互に重なる部分 (網目を付した部分) では、複数の方向に電磁界が放射されることになる。なお、各棒グラフの左端は放射角度 $\theta = 0^\circ$ 、右端 (図示せず) は放射角度 $\theta = 180^\circ$ となり、放射された電磁界は導体板 3 1 に沿った伝搬となる。上述した例と同じ理由から、実用上は、 $N = 1, 0, 5 \leq \alpha \leq 2, \alpha \neq 1$ とするのが望ましい。図 7 は、この条件下における放射角度 θ のスロットピッチ p 依存性を示す図である。横軸は隣接スロット間のピッチ p [cm]、縦軸は放射角度 θ [°] である。ただし、管内波長 $\lambda_g = 12$ [cm] とした。

【0032】なお、ラジアルアンテナ 3 0 の放射面をなす導体板 3 1 には、図 8 (a) に示すように、対をなすスロット 3 4 A, 3 4 B をハの字形をなすように形成してもよい。ここで、図 8 (b) に示すように、導体板 3 1 の中心を O、略径方向に隣り合う 2 つのスロット 3 4 A の中心をそれぞれ 3 4 A 1, 3 4 A 2、略径方向に隣り合う 2 つのスロット 3 4 B の中心をそれぞれ 3 4 B 1, 3 4 B 2 とすると、O-3 4 A 1 間距離と O-3 4 B 1 間距離との差を略 $\lambda_g/4$ とする。3 4 A 2, 3 4 B 2 についても同様とする。また、上述した径方向における隣接スロット間のピッチ p は、O-3 4 A 1 間距離と O-3 4 A 2 間距離との差又は O-3 4 B 1 間距離と O-3 4 B 2 間距離との差により定義され、このように定義されたピッチ p を上述した (5) 式を満たすと共に $N \neq \alpha$ となるように設計することにより、導体板 3 1 の法線方向に対して傾斜する方向に電磁界を放射させることができる。この際、図 8 (a) に示すように、スロット 3 4 A, 3 4 B の対を螺旋状に形成してもよい。

【0033】次に、図 1 に示したエッティング装置の動作を説明する。基板 2 1 を載置台 2 2 の上面に置いた状態で、処理容器 1 1 内を例えば 0.01 ~ 10 Pa 程度の

*軸は隣接スロット間のピッチ p [cm]、縦軸は放射角度 θ [°] である。ただし、管内波長 $\lambda_g = 4$ [cm] とした。

【0030】次に、ラジアル導波路 3 6 内に誘電体部材 3 9 が配置されていない場合、すなわちラジアル導波路 3 6 内が空気 ($\epsilon_r = \epsilon_v = 1$) である場合を示す。 $\epsilon_r = 1$ のとき、(5) 式は

$$\dots \quad (9)$$

$$\dots \quad (10)$$

真空度にする。この真空度を維持しつつ、プラズマガス供給ノズル 1 5 からプラズマガスとして Ar を供給し、処理ガス供給ノズル 1 6 から CF₄ などのエッティングガスを流量制御して供給する。処理容器 1 1 内にプラズマガス及びエッティングガスが供給された状態で、高周波発生器 4 5 からの高周波の電磁界を矩形導波管 4 3、矩形・同軸変換器 4 2 及び同軸線路 4 1 を介してラジアルアンテナ 3 0 に供給する。

【0034】ラジアルアンテナ 3 0 に供給された電磁界は、導体板 3 1, 3 2 によって構成されるラジアル導波路 3 6 の中央部から外周部に向かって放射状に伝搬していく、導体板 3 1 に形成された多数のスロット 3 4 から少しづつ放射される。導体板 3 1 の径方向における隣接スロット間のピッチ p は、上述した (5) 式を満たすと共に $N \neq \alpha$ となるように設計されているので、導体板 3 1 の法線方向 (図 1 では Z 軸方向) に対して傾斜する方向に電磁界が放射される。導体板 3 1 は誘電体板 1 3 に平行に配置されているので、電磁界は誘電体板 1 3 の法

30 線方向 (図 1 では Z 軸方向) に対して傾斜する方向に放射されることになる。この高周波の電磁界は、誘電体板 1 3 を透過して処理容器 1 1 内に導入され、処理容器 1 1 に電界を形成して Ar を電離させることにより、処理対象の基板 2 1 の上部空間 S 1 にプラズマを生成する。このエッティング装置では、載置台 2 2 に負電位をバイアスすることにより、生成されたプラズマからイオンが引き出されて、基板 2 1 に対してエッティング処理が行われる。

【0035】次に、図 1 に示したエッティング装置の効果を、図 2 0 に示した従来のエッティング装置と対比して説明する。ここでは図 1, 図 2 0 に示したエッティング装置で生成されたプラズマの分布を調べるために、これらのプラズマの写真撮影を行った。図 9 は、この写真撮影に使用した装置の説明図である。ここで、図 9 (a) は図 2 0 に示したエッティング装置のラジアルアンテナ 1 3 0 の寸法を示す断面図、図 9 (b) は図 1 に示したエッティング装置のラジアルアンテナ 3 0 の寸法を示す断面図、図 9 (c) は CCD カメラの配置図である。

【0036】プラズマの写真撮影は、図 9 (c) に示すように、基板 2 1, 1 2 1 が置かれていらない載置台 2

2, 122 の中央部に CCD カメラ 29 を配置し、管内波長 λ_g がおよそ 4 cm である電磁界を処理容器 11, 111 内に放射したときのプラズマ生成空間 S 1 を撮影することにより行った。このとき、従来のエッティング装置に関しては、図 9 (a) に示すような寸法のラジアルアンテナ 130 を使用した。すなわち、導体板 131 の直径を 4.8 cm、厚みを 0.03 cm、径方向における隣接スロット間のピッチ p_2 を 4 cm ($= \lambda_g$) とし、リング部材 133 の高さを 0.5 cm とした。また、図 1 に示したエッティング装置に関しては、図 9 (b) に示すような寸法のラジアルアンテナ 30 を使用した。すなわち、導体板 31 の直径と厚み、リング部材 33 の高さを上記ラジアルアンテナ 130 と同寸法とし、導体板 31 の径方向における隣接スロット間のピッチ p を 3.5 cm ($= 0.875 \lambda_g$) とした。

【0037】図 10 は、このような条件の下でプラズマを写真撮影したときに得られた像の模式図であり、図 10 (a) は図 20 に示したエッティング装置で得られた像、図 10 (b) は図 1 に示したエッティング装置で得られた像を示している。図 10 (a) に示されているように、隣接スロット間のピッチ $p_2 = \lambda_g$ であるラジアルアンテナ 130 を使用した従来のエッティング装置では、プラズマ発生領域 160 の中央付近に、プラズマが高密度に発生する部分 161A, 161B が観測された。これに対して、隣接スロット間のピッチ $p = 0.875 \lambda_g$ であるラジアルアンテナ 30 を使用した図 1 に示したエッティング装置では、図 10 (b) に示すように、プラズマ発生領域 60 にプラズマが高密度に発生する部分 161A, 161B ではなく、均一に分布するプラズマが観測された。このように図 1 に示したエッティング装置では、従来のエッティング装置と比較して均一に分布するプラズマを生成できるので、基板 21 に対するエッティングの斑を抑制できるという効果が得られる。

【0038】次に、図 1 に示したような構造を有するラジアルアンテナ 30 を使用することで、プラズマの分布を改善できた理由を説明する。ラジアルアンテナ 30 から処理容器 11 に導入された電磁界の一部がプラズマ生成においても吸収されず、ラジアルアンテナ 30 とプラズマ生成空間 S 1 との間の空間 S 2 に定在波を形成し、この定在波の電界がプラズマ生成に関わっていることは、従来のエッティング装置と同様である。したがって、図 1 に示したエッティング装置でも、ラジアルアンテナ 30 からプラズマへ直接入射した電磁界の電界と、処理容器 11 内に形成された定在波の電界の両方がプラズマ生成に関与していると言える。

【0039】図 11 は、Z 軸方向 (図 1 では垂直方向) に対して垂直なプラズマ面を有するプラズマの密度変化及びこのプラズマに入射した電磁界の電界強度変化を示す概念図である。図 11 (a) において、横軸はプラズマと誘電体板 13 との境界面から Z 軸方向の距離であ

り、縦軸はプラズマ密度及び電界強度である。また、Z 軸に垂直に X 軸を設けると、実線は電磁界の電界 E の X 軸方向成分 (すなわち、プラズマ面に平行な方向成分) E_x の強度、点線は電磁界の電界 E の Z 軸方向成分 (すなわち、プラズマ面の法線方向の成分) E_z の強度、一点鎖線はプラズマ密度をそれぞれ示している。プラズマ面が Z 軸に対し垂直なプラズマの密度は、プラズマと誘電体板 13 との境界面から Z 軸方向に離れるにしたがって、図 11 (a) の一点鎖線で示すように上昇していく。ここで、ある周波数に対してプラズマの誘電率がゼロになる密度を、その周波数におけるカットオフ密度という。

【0040】このようなプラズマに対して、図 11 (b) に示すように電磁界を Z 軸方向に対して傾斜する方向に入射させた場合、電界の X 軸方向成分 E_x の強度は図 11 (a) の実線で示すように、プラズマ密度がカットオフ密度となる地点 Z 1 までほぼ一定値を維持するが、この地点 Z 1 をこえると指数関数的に低下する。これに対して、電界の Z 方向成分 E_z の強度は図 11 (a) の点線で示すように、プラズマに入射した直後から上昇し、地点 Z 1 で極大を示してから下降に転ずる。この原理は「R.B.White, F.F.Chen, Amplification and Absorption of Electromagnetic Waves in Overdense Plasmas, Plasma Physics, vol. 16, pp565-587」に記載されている。Z 軸方向 (すなわちプラズマ面の法線方向) に対して傾斜する方向に電磁界を入射させれば、電界の Z 方向成分 E_z ができるので、Z 軸方向に入射させた場合と比較して、両成分 E_x, E_z を合成した電界強度を大きくすることができる。

【0041】図 1 に示したエッティング装置では、ラジアルアンテナ 30 からの電磁界は垂直方向 (Z 軸方向) に対して傾斜する方向に放射され、水平配置された誘電体板 13 の法線方向 (Z 軸方向) に対して所定の角度をもって入射する。一方、処理容器 11 内のプラズマ生成空間 S 1 は誘電体板 13 により制約されるので、誘電体板 13 と対向するプラズマ面はこの誘電体板 13 に沿った形状となり水平面となる。したがって、ラジアルアンテナ 30 から放射された電磁界は、誘電体板 13 と対向するプラズマ面の法線方向 (Z 軸方向) に対して傾斜する方向に入射することになる。

【0042】したがって、上述した原理にしたがえば、ラジアルアンテナ 30 を使用することにより、プラズマ生成空間 S 1 に従来よりも大きな電界を形成できるので、ラジアルアンテナ 30 から直接入射した電磁界の電界によるプラズマ生成効率を向上させることができる。これにより、ラジアルアンテナ 30 から直接入射した電磁界の電界によるプラズマ生成への寄与が大きくなり、処理容器 11 内の空間 S 2 に形成される定在波の電界によるプラズマ生成への関与が相対的に低くなる。

【0043】ラジアルアンテナ 30 からプラズマへ直接

入射した電磁界の電界によるプラズマの生成は、比較的容易に制御できる。例えば、放射面（導体板31）に形成される各スロットの長さを径方向で調整して、各スロットから放射される電界の強度を適当に調整することで、プラズマの生成を制御できる。これに対して、定在波の電界によるプラズマの生成は制御が困難である。図1に示したエッチング装置では、上述したように、直接入射した電磁界の電界によるプラズマ生成を、定在波の電界によるプラズマ生成よりも優勢にすることができるので、所望のプラズマ分布となるようにプラズマの生成を制御することができる。よって、図10(b)に示したような均一なプラズマ分布を得ることができた。

【0044】図12は、電磁界の吸収係数の角度依存性を示す図である。横軸は電磁界の放射角度 θ （図3参照）の余弦であり、縦軸は吸収係数 η である。この図から、プラズマ中の電子密度 n_e にもよるが、放射角度 θ がおよそ $30^\circ \sim 50^\circ$ において吸収係数が最大となることが分かる。したがって、このような角度 θ で電磁界を放射することにより、ラジアルアンテナ30から直接入射した電磁界によるプラズマ生成が支配的になるので、プラズマ分布の制御を正確に行うことができる。なお、隣接スロット間のピッチ p は、径方向（すなわち、ラジアル導波路36内における電磁界の伝搬方向）で一定であってもよいし、変化していてもよい。径方向で隣接スロット間のピッチ p に変化をつけると、この径方向で電磁界の放射方向が変化する。図12から分かるように、電磁界の放射方向が変化すれば電磁界の吸収係数も変化するので、径方向でプラズマの生成効率を制御して*

$$p/\lambda_a + (p \cdot \cos \theta)/\lambda_a = N$$

ここで、 λ_a はアンテナ30の外部を伝搬する電磁界51A, 51Bの波長、Nは0以上の整数である。※

で表されるので、この(12)と、(2)式で定義した

$$\cos \theta = (\epsilon_v / \epsilon_a)^{1/2} \cdot [(N/\alpha) - 1]$$

となる。 $\epsilon_v / \epsilon_a = \epsilon_r$ とすると、(13)式は、

$$\cos \theta = \epsilon_r^{1/2} [(N/\alpha) - 1]$$

となる。

$$-1 \leq \epsilon_r^{1/2} [(N/\alpha) - 1] \leq 1$$

の関係を満たす必要がある。このとき、角度 θ が

$$\theta = \cos^{-1} [\epsilon_r^{1/2} [(N/\alpha) - 1]]$$

となる方向で電磁界51A, 51Bの位相がそろい、この方向に電磁界が放射されることになる。したがって、電磁界の放射に関して、以下の事項が導き出される。

【0049】1. N=0の場合： $\theta = \cos^{-1} (-\epsilon_r^{1/2})$ であるから、

① $\epsilon_r > 1$ の場合、解がなく、電磁界は放射されない。

② $\epsilon_r = 1$ の場合、 $\theta = 180^\circ$ となり、水平方向に電磁界51A, 51Bが放射される。

$$N \geq \alpha \cdot [1 - (1/\epsilon_r^{1/2})]$$

* プラズマ分布を調整することができる。

【0045】以上ではラジアルアンテナ30を用いた例を説明したが、これに限定されるものではなく、他のスロットアンテナ、例えば矩形導波路アンテナを用いても同様の効果を得られる。図13は、本発明に使用可能な矩形導波路アンテナアレーの構成を示す斜視図である。このアンテナアレーは、矩形導波路の一面に複数のスロット74が形成された矩形導波路アンテナ70を、その短め方向に連続配置したものである。ここで、矩形導波路アンテナ70のスロット74は、矩形導波路内における電磁界の伝搬方向に等間隔に形成され、隣接スロット間のピッチ p は、上述した(5)式を満たすと共に $N \neq \alpha$ となるように設計されている。なお、スロットを図8に示したようにハの字形に形成してもよい。また、隣接スロット間のピッチ p を、矩形導波路内における電磁界の伝搬方向で変化をつけてもよい。図13において、81は高周波発生器（図示せず）に接続された電磁界分配用の矩形導波路である。

【0046】(第2の実施の形態) ラジアルアンテナ30の放射面（導体板31）に多数形成されるスロット34のピッチ p の設計方法に関する、第1の実施の形態では、アンテナ30外部の等価比誘電率 ϵ_a を1に近似したときの設計方法について説明したが、ここではそれを一般論に拡張して説明する。図3において、A点から放射される電磁界51Aと、A点からB点を経由してC点に達する電磁界51Bとが同じ位相となる条件は、(11)式に示すようになる。

$$\dots \quad (11)$$

【0047】真空中における電磁界の波長を λ とする

$$p = \alpha \cdot \lambda_g \text{ とを (11) 式に代入して整理すると、} \dots \quad (12)$$

$$p = \alpha \cdot \lambda_g \text{ とを (11) 式に代入して整理すると、} \dots \quad (13)$$

$$\dots \quad (14)$$

【0048】この(14)式より、 ϵ_r , N, α は

$$\dots \quad (15)$$

$$\dots \quad (16)$$

③ $\epsilon_r < 1$ の場合、電磁界は ϵ_r に依存した角度 θ に放射される。

【0050】2. Nが1以上で、 $N = \alpha$ の場合： $\cos \theta = 0$ すなわち $\theta = (2M-1) \pi/2$ (Mは自然数) となり、垂直方向に電磁界51A, 51Bが放射されることになる。

【0051】3. Nが1以上で、 $N \neq \alpha$ の場合：(15)式を変形すると、次の2式が得られる。

$$\dots \quad (17)$$

17

$$N \leq \alpha \cdot [1 + (1/\epsilon_r^{1/2})]$$

① $\epsilon_r > 1$ の場合

$$(17) \text{ 式から、 } \alpha \leq N/[1 - (1/\epsilon_r^{1/2})] \quad \dots \dots (18)$$

$$(18) \text{ 式から、 } \alpha \geq N/[1 + (1/\epsilon_r^{1/2})] \quad \dots \dots (20)$$

したがって、Nと α との関係は、

$$N/[1 + (1/\epsilon_r^{1/2})] \leq \alpha \leq N/[1 - (1/\epsilon_r^{1/2})] \quad \dots \dots (21)$$

となる。

【0052】

② $\epsilon_r < 1$ の場合

$$(17) \text{ 式から、 } \alpha \geq N/[1 - (1/\epsilon_r^{1/2})] \quad \dots \dots (22)$$

ただし、(2)式より、 $\alpha > 0$ 10

$$(18) \text{ 式から、 } \alpha \leq N/[1 + (1/\epsilon_r^{1/2})] \quad \dots \dots (23)$$

したがって、Nと α との関係は、

$$0 \leq \alpha \leq N/[1 + (1/\epsilon_r^{1/2})] \quad \dots \dots (24)$$

となる。

【0053】③ $\epsilon_r = 1$ の場合

* (15) 式より

$$-1 \leq (N/\alpha) - 1 \leq 1 \quad \dots \dots (25)$$

となるので、Nと α との関係は、

$$\alpha \geq N/2$$

となる。

【0054】以上より、ラジアルアンテナ30の放射面（導体板31）に形成されるピッチ p の設計に関して、次のように言える。すなわち、径方向における隣接スロット間のピッチ p を(15)式を満たすように設計することにより、所定の角度 θ に電磁界を放射させることができる。この放射角度 θ は、ラジアルアンテナ30の内外の比誘電率の比 ϵ_r によって決定される。ただし、Nが1以上で $N = \alpha$ ($= p/\lambda_g$)の場合には、放射面に対して垂直方向に電磁界が放射されるので、Nが1以上の場合には $N \neq \alpha$ となるようにピッチ p を設計することにより、垂直方向に対して傾斜する方向に電磁界を放射させることができる。以上説明したように、プラズマ処理※

$$\epsilon_a = \epsilon_1 \cdot \epsilon_2 / [\epsilon_1 \cdot (1 - \beta) + \epsilon_2 \cdot \beta] \quad \dots \dots (27)$$

で求められる。ここで、

$$\beta = d_1/d$$

である。

【0056】いま、図15に示すように、誘電体板13とラジアルアンテナ30の放射面との距離を d_2 から d だけ小さくすると、 d も Δd だけ小さくなるので(28)式より β が大きくなり、 $\epsilon_1 \neq \epsilon_2$ の場合には ϵ_a が変化する。一方、(16)式から分かるように、放射角度 θ はラジアルアンテナ30の内外の比誘電率の比 $\epsilon_r = \epsilon_v/\epsilon_a$ で決定されるので、 ϵ_a が変化すれば放射角度 θ も変化する。したがって、ラジアルアンテナ30を上下に動かして、誘電体板13からラジアルアンテナ30の放射面までの距離を変えることにより、放射角度 θ を制御することができる。

【0057】図16は、ラジアルアンテナ30を上下に動かしたときのプラズマ分布の変化を示す概念図である。横軸は処理容器11の中心軸(O)から半径方向への距離であり、縦軸はプラズマ密度である。この図から

18

... (18)

※装置の使用状況に応じて変化するラジアルアンテナ30
20 外部の等価誘電率 ϵ_a を考慮し、アンテナ30の内外の比誘電率の比 ϵ_r に基づいてピッチ p を設計することにより、適切なスロット配置を得られる。

【0055】(第3の実施の形態) 図14は、図1に示したラジアルアンテナ30から誘電体板13に至る一部構成を拡大して示す断面図である。誘電体板13の厚みと比誘電率をそれぞれ d_1 , ϵ_1 、この誘電体板13とラジアルアンテナ30の放射面(導体板31)との間の距離と比誘電率をそれぞれ d_2 , ϵ_2 とし、 $d_1 + d_2 = d$ とする。この場合、ラジアルアンテナ30外部の等価比誘電率 ϵ_a は、

30

... (27)

分かるように、誘電体板13からラジアルアンテナ30の放射面までの距離を $d_2 - \Delta d$, d_2 , $d_2 + \Delta d$ (Δd は数mm程度)と変化させることにより、それに応じてプラズマ分布が変化する。以上より、誘電体板13からラジアルアンテナ30の放射面までの距離を変えて、電磁界の放射方向を変えることにより、プラズマの分布を調整できると言える。

【0058】(第4の実施の形態) 図17は、本発明の第4の実施の形態であるエッティング装置の構成を示す図である。この図において、図1と同一部分を同一符号をもって示し、適宜その説明を省略する。このエッティング装置では、ラジアルアンテナ30の放射面(導体板31)に対向配置される誘電体板13Aが、ドーム状をしている。したがって、この誘電体板13Aは、ラジアルアンテナ30の放射面に対して傾斜する面を有している。なお、誘電体板13Aは、載置台22の載置面に対

して垂直な中心軸に対して、対称な形状をしている。

【0059】処理容器11内のプラズマ生成空間S1は誘電体板13Aにより制約されるので、誘電体板13Aと対向するプラズマ面はこの誘電体板13Aに沿った曲面となる。このプラズマ面の法線方向は、中心軸付近を除き、鉛直方向（Z軸方向）に対して傾斜しているので、仮に電磁界を鉛直方向（Z軸方向）に放射しても、その電磁界はプラズマ面の法線方向に対して傾斜する方向に入射することになる。このように、ドーム状の誘電体板13Aを用いることにより、図1に示したエッチング装置と同様の条件を作り出すことが可能である。

【0060】しかし、3～30mmという比較的薄い誘電体板をドーム状に成形すると、曲率が必要以上に大きくなり、所望の曲率に成形することができない場合がある。一方、比較的厚い誘電体板を用いれば曲率を小さくすることは可能であるが、電磁界の損失が大きくなってしまう。そこで、誘電体板13Aの曲率が必要以上に大きい場合には、放射面（導体板31）の法線方向に対して傾斜する方向に電磁界を放射するラジアルアンテナ30を用いて、誘電体板13Aへの電磁界の入射角を小さくするとよい。このようにして処理容器11内における電界強度の分布を調整することにより、プラズマの分布を改善することができる。ここで、径方向で隣接スロット間のピッチ ρ に変化をつけて、この方向で電磁界の放射方向に分布をもたせることにより、プラズマの分布を調整してもよい。なお、誘電体板13Aは、ラジアルアンテナ30の放射面（導体板31）に対して傾斜する面を有していればよいので、上又は下に凸の円錐面状など、他の凸形状であってもよい。

【0061】（第5の実施の形態）図18は、本発明の第5の実施の形態であるエッチング装置の構成を示す図である。この図において、図1及び図17と同一部分を同一符号をもって示し、適宜その説明を省略する。このエッチング装置は、ドーム状の誘電体板13Aに代えて、処理位置にある基板21の周囲を覆う半球状又はドーム状のベルジャー18を有している。具体的には、半球状又はドーム状のベルジャー18の開口部を下側にして処理位置上方からかぶせ、処理位置下方の処理容器11側壁にベルジャー18の開口部を固定した構造となっている。したがって、プラズマが比較的高密度で存在する空間に近接する処理容器11Aの側壁は、ベルジャー18により載置台22Aから隔離される。このベルジャー18は、厚さ3～30mm程度の石英ガラス又は（Al₂O₃又はAlN等の）セラミックなどの誘電体で形成されている。また、処理容器11とベルジャー18との接合部には、Oリングなどのシール部材12Aを介在させている。

【0062】基板21が配置される載置台22Aは、処理容器11Aの底部を遊貫する昇降軸28によって支持され、上下動自在となっている。基板を搬入搬出口19

から搬入又は搬出するときは、載置台22Aを下に降ろし、エッチング処理を行うときは、載置台22Aを上げて基板21を処理位置に配置することができる。処理容器11の底部には、セラミックなどからなる絶縁板24Aが設けられている。また、処理容器11Aとベルジャー18とで形成された処理室の気密性を確保するため、載置台22Aと絶縁板24Aとの間に、昇降軸28を囲むようにペローズ29が設けられている。さらに、処理容器11Aの底部には、真空ポンプ（図示せず）に接続された排気口14Aが設けら、処理容器11Aの側壁には、処理室内にプラズマガス及びエッチングガスを導入するためのノズル15Aが設けられている。このノズル15Aは基板12の処理位置の上側までのびており、ガスが載置台22Aの上部空間に放出されるようになっている。

【0063】上述したように、ベルジャー18は半球状又はドーム状をしており、ラジアルアンテナ30の放射面（導体板31）に対して傾斜する面を有している。したがって、図17に示したエッチング装置と同様に、放射面の法線方向に対して傾斜する方向に電磁界を放射するラジアルアンテナ30を用いて、処理室における電界強度の分布を調整することにより、プラズマの分布を改善することができる。また、プラズマ生成空間S1を含むプラズマが比較的高密度で存在する空間に近接する領域では、処理容器11Aの側壁がベルジャー18でカバーされているので、生成されたプラズマが処理容器11Aの側壁に接触して表面をスッパーすることによって起こる処理室の汚染を抑制することができる。なお、半球状又はドーム状のベルジャーが載置台22Aの載置面に乗る構造にして、載置台22Aとベルジャーとにより処理室が形成されるようにしてもよい。

【0064】（第6の実施の形態）以上では、本発明をエッチング装置に適用した例を説明してきたが、例えばプラズマCVD（chemical vapor deposition）装置などの他のプラズマ処理装置に本発明を適用してもよい。そこで次に、本発明をCVD装置に適用した例を説明する。図19は、本発明の第6の実施の形態であるCVD装置の構成を示す図である。この図において、図1及び図18と同一部分を同一符号をもって示し、適宜その説明を省略する。このCVD装置は、基板21を加熱するヒーター91や、処理室内にSiH₄とH₂との混合ガスなどを導入するガス供給ノズル92など、CVD装置に必要な構成を有するほか、放射面の法線方向に対して傾斜する方向に電磁界を放射するラジアルアンテナ30と、処理位置にある基板21の周囲を覆う半球状又はドーム状のベルジャー（第1の誘電体部材）18とを備え、図19に示したエッチング装置と同様の特徴を有している。

【0065】また、このCVD装置では、処理容器11Aの上部開口が誘電体板（第2の誘電体部材）13で密

閉されている。また、ベルジャー18と誘電体板13と処理容器11Aとによって囲まれた密閉空間に所定温度のガスを流通させてベルジャー18を温度調整するため、流通手段としてノズル93と排気口94とが処理容器11Aの側壁に設けられている。ノズル93から導入されるガスには、高周波電磁界を吸収しにくいガスとして例えばN₂が用いられる。このガスの温度は、ベルジャー18よりも高い温度に設定され、その上限は600°Cとする。

【0066】図19に示したCVD装置の動作を説明する。まず、ヒーター91を150°C程度にして基板21を加熱した状態で、ガス供給ノズル92から処理室内にSiH₄とH₂との混合ガスを導入する。ラジアルアンテナ30から処理室内に電磁界を供給すると、SiH₄が解離してSiH_x(x=1, 2, 3, 4)となり、このSiH_xが基板21の表面で反応してアモルファスSi(以下、a-Siと略記する)が成膜される。このとき、ベルジャー18が常温であれば、ベルジャー18の内面にSiH_xが付着し、a-Siが成膜される。このa-Siによってラジアルアンテナ30からの電磁界の導入が阻害されることになる。しかし、ベルジャー18と誘電体板13との間の空間に600°C以下の温度、例えば150°C~300°CのN₂を流通させてベルジャー18を加温することによりSiH_xが付着しにくくなるので、ベルジャー18内面におけるa-Siの成膜を低減できる。したがって、ベルジャー18を介して処理室内に導入される電磁界の損失を低減し、効率よくプラズマを生成して成膜を行うことができる。

【0067】なお、ベルジャー18と誘電体板13と処理容器11Aとによって囲まれた密閉空間に流通させる流体は、ガスに限らず、液体であってもよい。この場合、例えばガルデン(パーフルオロポリエーテル)又はフロリケートなど、高周波電磁界を吸収しにくい液体を用いることが好ましい。また、上記の温度より低温の流体を密閉空間に流通させて、ベルジャー18を冷却するようにもよい。電磁界の作用によってベルジャー18の温度が高くなりすぎると、ベルジャー18が破損する原因となる。また、図18に示したエッチング装置では、ベルジャー18の輻射熱で基板21上のレジストが焼け、所望のパターンにエッチングできないことがある。しかし、このようにしてベルジャー18を冷却することにより、上記の問題を回避することができる。また、ベルジャー18と共に密閉空間を形成する第2の誘電体部材は、ベルジャー18に対して載置台22A又は基板21と異なる側に配置されればよい。したがって、ラジアルアンテナ30の給電線である同軸線路41の途中に第2の誘電体部材を詰めて密閉空間を形成してもよい。この場合、ラジアルアンテナ30の内部にも流体が流通することになる。

【0068】

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、スロットアンテナから処理容器内に電磁界を放射する際に、アンテナ放射面の法線方向に対して傾斜する方向に電磁界を放射するものである。これにより、スロットアンテナから直接入射する電磁界によるプラズマ生成を、処理容器内で形成される定在波の電界によるプラズマ生成よりも優勢にすることができる。前者は後者よりも制御が容易であるので、プラズマの分布を従来よりも改善することができる。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態であるエッチング装置の構成を示す図である。

【図2】 ラジアルアンテナの放射面をなす第1の導体板の一構成例を示す図である。

【図3】 第1の導体板の径方向における隣接スロット間のピッチpの設計方法の説明図である。

【図4】 比誘電率ε_r=9のときのNとαとの関係を棒グラフで表した図である。

【図5】 比誘電率ε_r=9のときにおける放射角度θのスロットピッチp依存性の一例を示す図である。

【図6】 比誘電率ε_r=1のときのNとαとの関係を棒グラフで表した図である。

【図7】 比誘電率ε_r=1のときにおける放射角度θのスロットピッチp依存性の一例を示す図である。

【図8】 ラジアルアンテナの放射面をなす第1の導体板の他の構成例を示す図である。

【図9】 プラズマの写真撮影に使用した装置の説明図である。

【図10】 プラズマを写真撮影したときに得られた像の模式図である。

【図11】 Z軸方向に対して垂直なプラズマ面を有するプラズマの密度変化及びこのプラズマに入射した高周波の電界強度変化を示す概念図である。

【図12】 電磁界の吸収係数の角度依存性を示す図である。

【図13】 本発明に使用可能な矩形導波路アンテナアレーの構成を示す斜視図である。

【図14】 図1に示したラジアルアンテナから誘電体板に至る一部構成を拡大して示す断面図である。

【図15】 図14に示した誘電体板とラジアルアンテナの放射面との距離を狭めたときの断面図である。

【図16】 ラジアルアンテナを上下に動かしたときのプラズマ分布の変化を示す概念図である。

【図17】 本発明の第4の実施の形態であるエッチング装置の構成を示す図である。

【図18】 本発明の第5の実施の形態であるエッチング装置の構成を示す図である。

【図19】 本発明の第6の実施の形態であるエッチング装置の構成を示す図である。

50 【図20】 従来の高周波プラズマ処理装置を用いた工

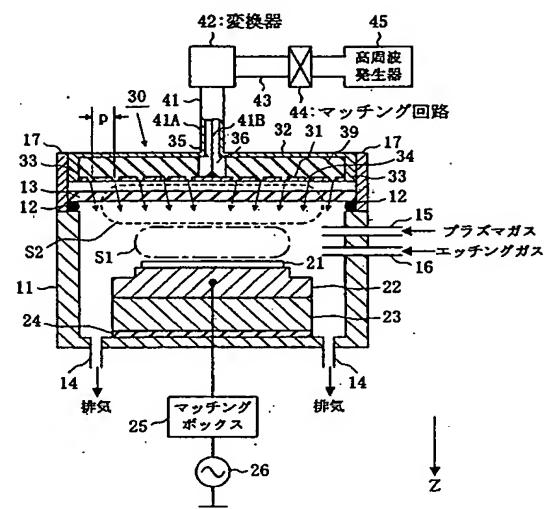
ツチング装置の構成図である。

【符号の説明】

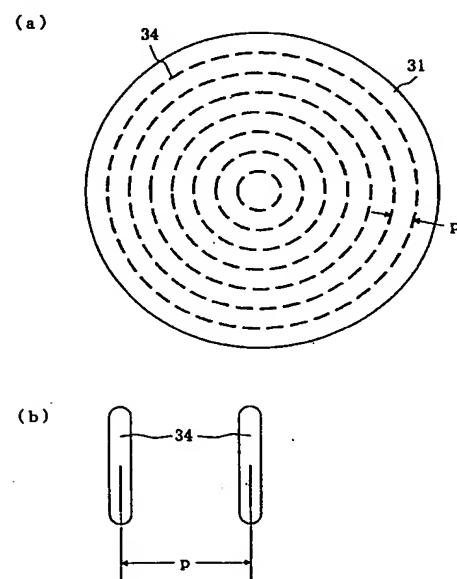
1 1 … 处理容器、1 3 … 誘電体板、2 1 … 基板、2 2 …

載置台、3 0 … ラジアルアンテナ、3 1 … 導体板、3 4, 3 4 A, 3 4 B, 7 4 … スロット、3 5 … 導入口、7 0 … 矩形導波路アンテナ。

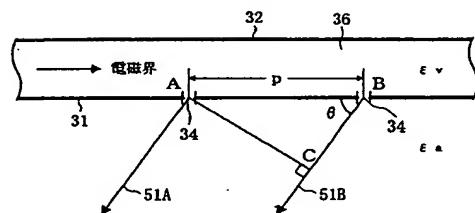
【図 1】



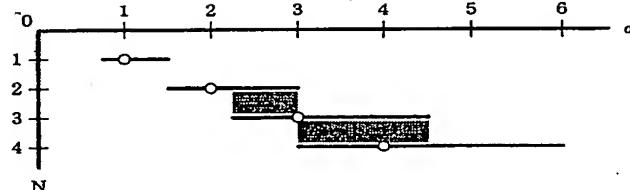
【図 2】



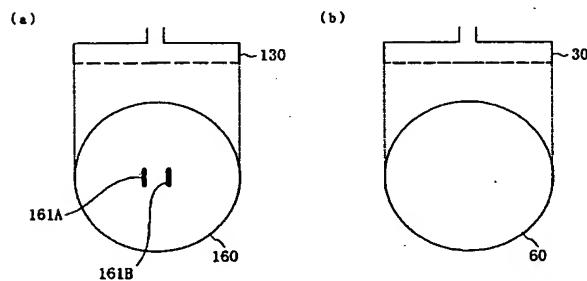
【図 3】



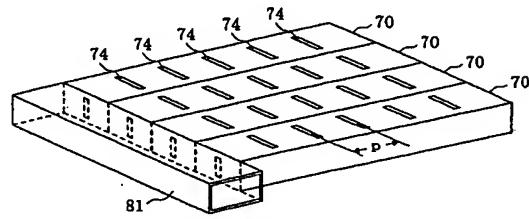
【図 4】



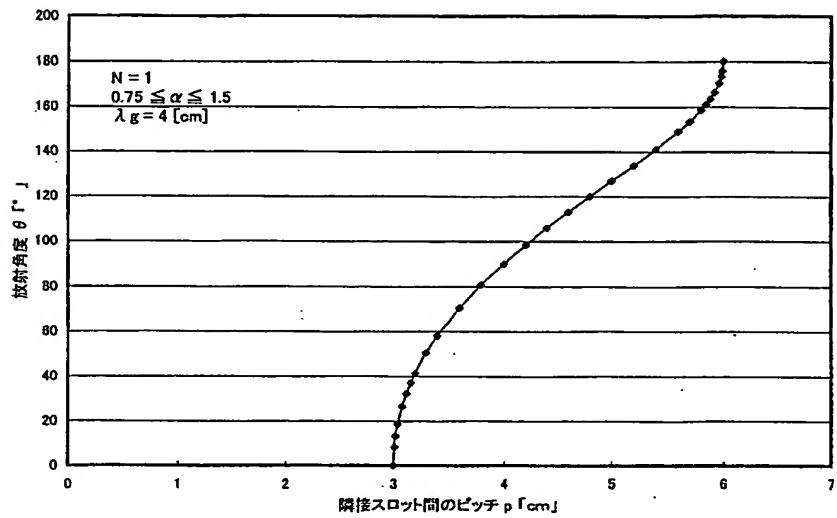
【図 10】



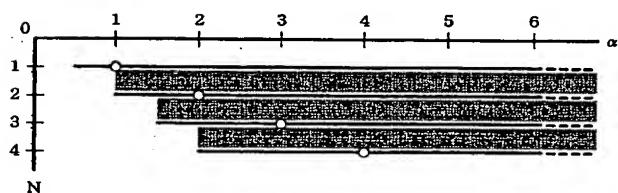
【図 13】



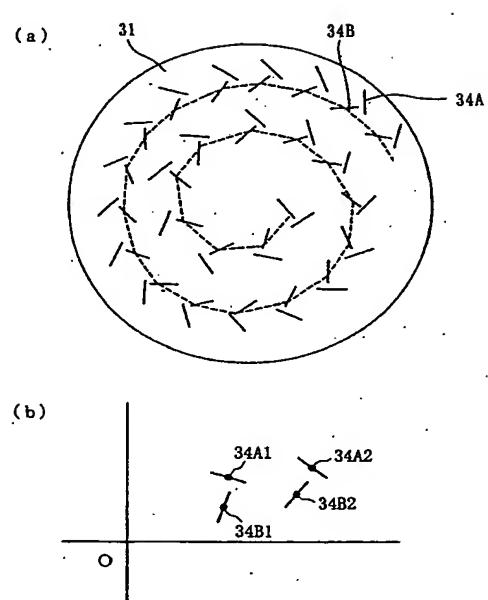
【図5】



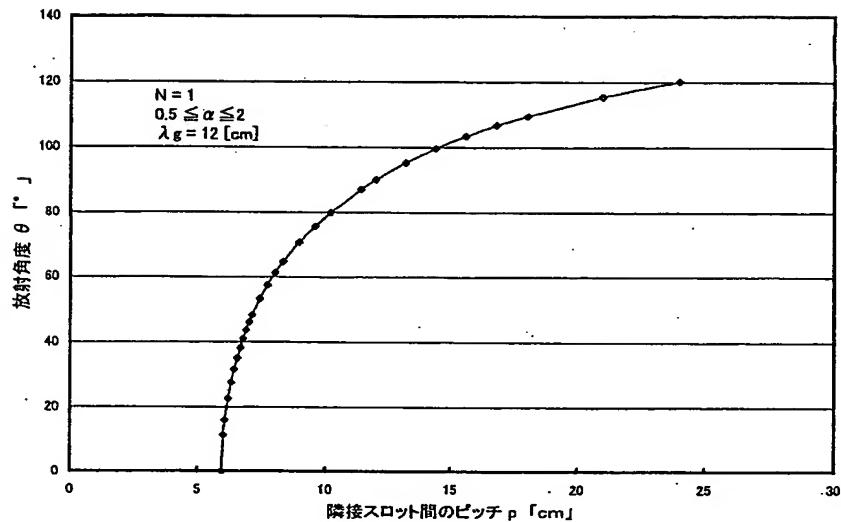
【図6】



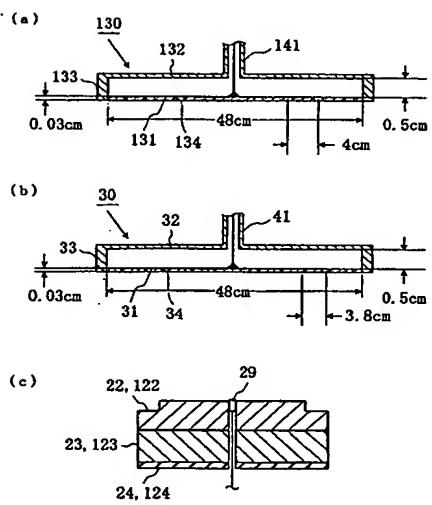
【図8】



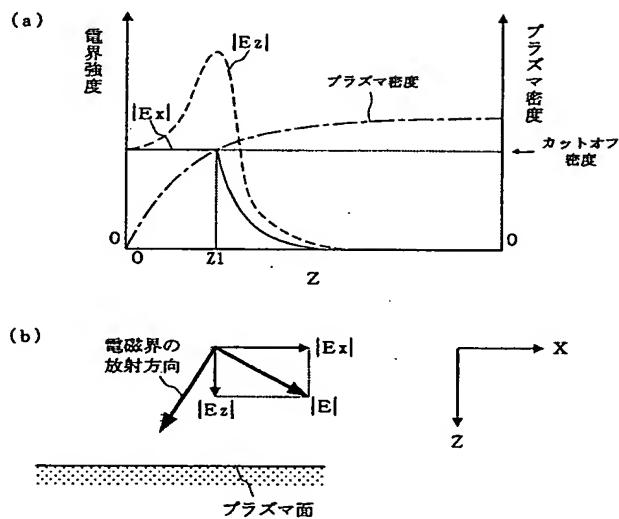
【図7】



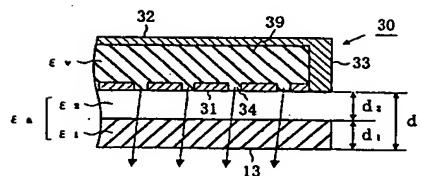
【図9】



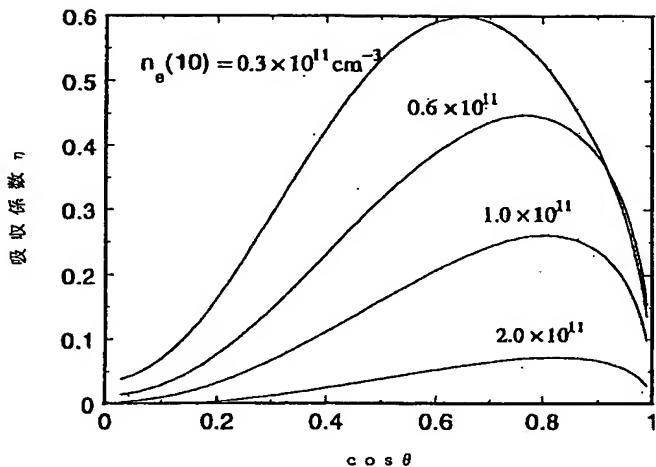
【図11】



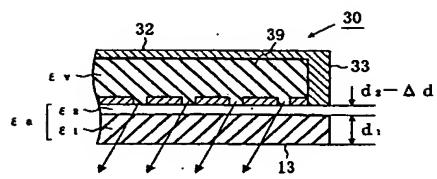
【図14】



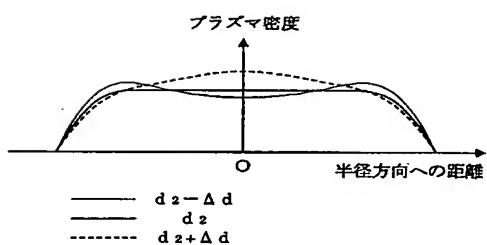
【図12】



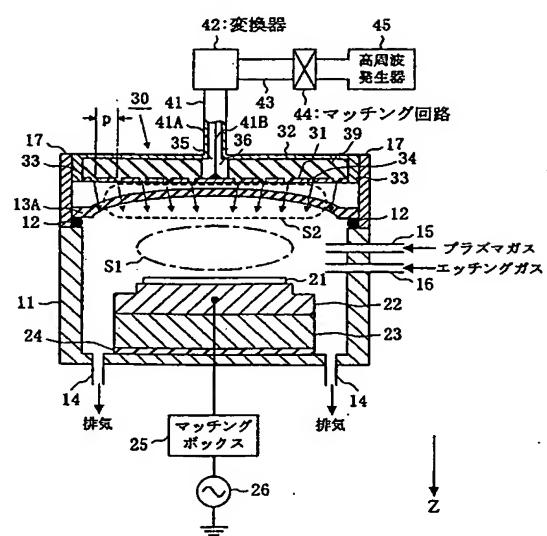
【図15】



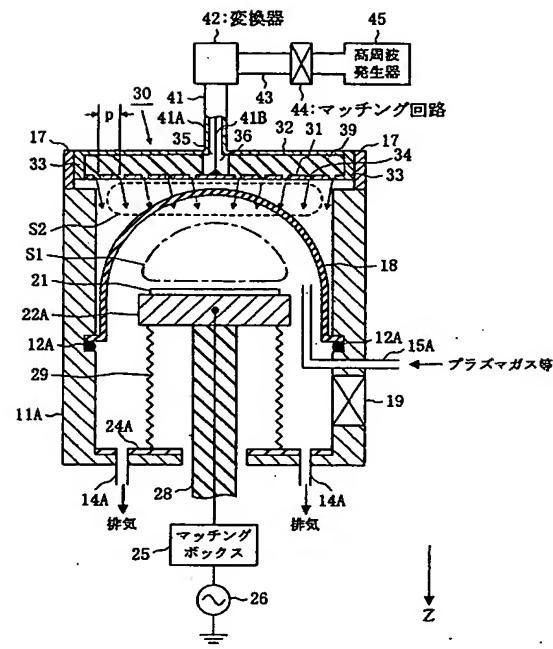
【図16】



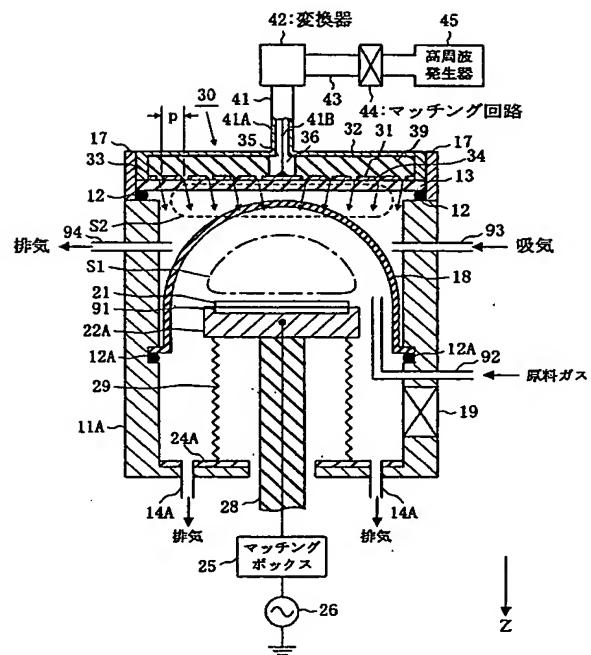
【図17】



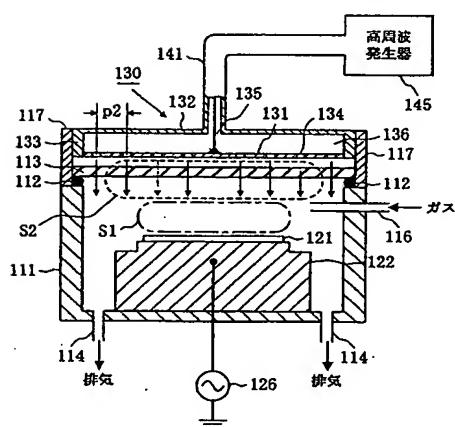
【図18】



【図19】



【図20】



フロントページの続き

F ターム(参考) 4G075 AA24 AA30 AA61 BC01 BC04
BC06 CA24 CA25 CA47 EA01
EB01 EB41 EC30 FC15
4K030 FA03 JA14 KA10 KA15 KA30
KA46
5F004 BA20 BB11 BB32 DA01 DA23
5F045 AA09 AB04 AC01 AC15 AD05
AD06 AD07 BB15 DP04 EB02
EH02 EH03 EJ01



United States Patent [19]

Uematsu et al.

Patent Number: 5,579,019

Date of Patent: Nov. 26, 1996

(2)

[54] SLOTTED LEAKY WAVEGUIDE ARRAY ANTENNA

[75] Inventors: Masahiro Uematsu, Kimitsu; Takashi Ojima, Chiba; Nobuharu Takahashi, Tokyo; Naohisa Goto, 15-1-A514, Tsuchihashi-6-chome, Miyamae-ku, Kawasaki-shi; Jiro Hirokawa, Tokyo; Makoto Ando, Kawasaki, all of Japan

[73] Assignees: Nippon Steel Corporation, Tokyo; Naohisa Goto, Kawasaki, both of Japan

[21] Appl. No.: 580,787

[22] Filed: Dec. 29, 1995

of Electronics, Information and Communication Engineers), AP88-40, Jul. 1988.

Ohmaru "Mobile Reception Apparatus for Broadcast by Satellite", Broadcasting Technology, vol. 43, No. 9, pp. 119-123, Sep. 1990.

Kuramoto, et al. "Antenna System for Mobile DBS Reception", Proceedings of the General Meeting of IEICE in Spring, 1991, B-59, Mar. 1991.

Nishikawa "Mobile Antenna System for Receiving Broadcast by Satellite", Toyoda Chuo Research R&D Review, vol. 27, No. 1, p. 65, Mar. 1992.

Hirokawa, et al. "Design of Slotted Leaky Waveguide Array Antenna", Technical Report of IEICE, AP92-37, 1992-5.

Nakano, et al. "Curl Antenna (III) Beam Tilt", Proceedings of the General Meeting of IEICE in Spring, B-45, Mar. 1993.

(List continued on next page.)

[63] Continuation of Ser. No. 169,215, Dec. 20, 1993, abandoned.

[30] Foreign Application Priority Data

Oct. 7, 1993 [JP] Japan 5-276152

[51] Int. Cl.⁶ H01A 13/10

[52] U.S. Cl. 343/771; 343/770

[58] Field of Search 343/771, 767, 343/770; H01Q 13/10, 13/18, 13/20, 13/22

[56] References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

3,032,762	5/1962	Kerr	343/771
3,701,162	10/1972	Seaton	343/771
4,916,458	4/1990	Goto	343/771

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

0029004	1/1989	Japan	H01Q 13/10
5129828	5/1993	Japan	H01Q 13/22

OTHER PUBLICATIONS

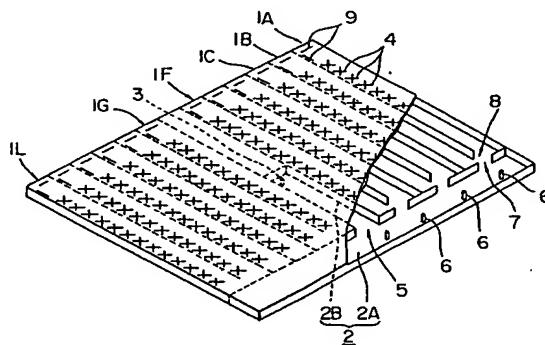
Furukawa, et al. "Beam Tilt Type Planar Antenna Using Waveguide of Single-Layer Structure for Receiving Broadcast by Satellite", Technical Report of IEICE (The Institute

**Primary Examiner—Donald T. Hajec
Assistant Examiner—Tho Phan
Attorney, Agent, or Firm—Pollock, Vande Sande & Priddy**

[57] ABSTRACT

A slotted leaky waveguide array antenna of a one-axis tracking type wherein a feed section including a feed probe is kept in a stationary state to thereby keep a converter in a stationary state and a desired beam width is set in a tilt direction, includes a plurality of radiation waveguides arranged adjacent and parallel to each other, each of which has a plurality of slots arranged in a waveguide axial direction, and a feed waveguide for distributing to the respective radiation waveguides electromagnetic waves received through a feed section from a converter, and the antenna rotates in a substantially horizontal plane to track an azimuth direction, wherein the feed waveguide has a first section extended along one ends of the radiation waveguides and a second section extended from the feed section provided in the rotary center of the slotted leaky waveguide array antenna to the center of the first section, and wherein the radiation waveguides are formed with crossed slots having an identical offset, and the number of the crossed slots is preferably selected between 13 and 17.

12 Claims, 12 Drawing Sheets



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.